



1) powierzchnia aktywna, 2) Szkło



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
Kształt anteny	okrągły
Woda zdeminielizowana	odporny
Zasada działania	Nośnik danych

Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	do 70 °C: 500.000 do 30 °C: 1.000.000
Czas odczytu	do 32x8 bitów: 0.19 s
Czas programowania	do 1x8 bitów: 0.3s do 32x8 bitów: 0.6s
Organizacja pamięci	32 × 8 bitów

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Maks. gradient temperatury	6 K/min
Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	10...70 °C
Temperatura przechowywania	10...126 °C

Functional Characteristics

Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	511 Byte
Typ pamięci	EEPROM

Material

Materiał obudowy	Szkło
------------------	-------

Mechanical data

Maks. ciśnienie	2.6 bar
Masa	0.90 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Wymiary	Ø 11 x 13 mm

LF (70/455 kHz)
BIS C-121-04/L-SA1
Kod artykułu: BIS000W

BALLUFF

Remarks

Tylko w połączeniu z przetwornikiem BIS C-901 lub BIS C-6xx i przewidzianą dla nich odpowiednią głowicą zapisu/odczytu.

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.

Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.

Informacja o czasie w tym kontrola danych.

IP68 sprawdzone wg BWN Pr 36

Na ostatniej stronie możliwe do zastosowania są tylko 31x8 bitów.

Odległość zapisu/odczytu patrz BIS C-121-04/L zredukowana o 0,8 mm.